

その結果、中国の半導体産業は、ここ数年で、途轍もない進化を遂げつつある。まず、設計を専門に行うファブレス企業数は、2012年の約500社から、5年間で1200社以上に増えた。企業数だけではなく、ファーウェイ傘下のハイシリコンが、米アップルの最新機種iPhone 5sに採用された。

リーでは、中国最大企業のSMICが、Dr. Liang Meng Song氏をCEOにスカウトした。Dr. Liang は、TSMC時代辣腕を揮った後、サムスン電子のファンドリーデ部分にヘッドハンントされ、アップルのiPh

一方、メモリでは工場が建設ラッシュになっている。2011年に3次元NAND参入することを表明した紫光集団傘下の長ストレージ（旧X-C）は、2017年に32層のサンプル出を開始し、現在は64

先端—I Xnmに参入することを表明している。それぞれ、月産30万枚規模を目指してお
り、Rui-LiとJ-HIICは、どちらも、月産10万枚の第1棟が完成し、装置の導入を開始している。
この3社が最先端のRAMを製造できるか

きる可能性がある。
この中国のDRAM
を極度に警戒してくる。
サムスン電子、SK
Hynix、マイクロ
ンの3社は、今年は
次元NANDの投資を
DRAMに転換し、微
細化投資と規模の投資
を限界まで行う計画で
ある。要するに、万が

「中国製造2025」を掲げ、「世界一の製造強国」になることを明確な目標に掲げた。その結果、中国の半導

漫遊記

one用プロセッサのビジネスを獲得するなど暗躍した。その大物を、SMICがサムスン電子から引き抜いたのである。これまで低空飛行が続いていたSMICであるが、Dr. Liangが加わったことにより、今後怖い存在になると予想さ

の試作に成功していく。また、月産10万枚の第1棟が完成し装置が導入され始めた。2020年に月産30万枚、2030年には月産100万枚の生産能力に増強する計画である。

どうかは、まだわから
ない。しかし、つくっ
てもつくっても足りな
い3次元NANDと違
つて、DRAMの需要
はそれほど大きくな
い。もし、中国の3社
のうちのどこかが1X
nm DRAMの製造に
成功したら、市場が破
壊され、価格暴落が起

中国、半導体大国へ着々

設計、製造、メモリ、OSATで

表1 中国半導体産業の躍進

| | ファブレス | ファンドリー | メモリ | | OSAT |
|---------|-----------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | | 3次元NAND | DRAM | |
| 企業動向 | 5年前の500社から1200社へ増大 | SMICが大物をスカウト | 紫光集団傘下の長江ストレージが16年に参入 | 3社が最先端1Xnmへ参入を表明 | トップ10内の3社の成長率が二桁増 |
| 技術や市場動向 | ファーウェー傘下のハイシリコンが10nmのSOCを設計 | 2020年までに16/14nmを大量生産予定 | 32層をサンプル出荷し、64層の開発に着手 月産10万枚の第1棟が完成 | RuiLiとJHICCが月産10万枚の第1棟に装置を導入中 | 装置導入で台湾を抜いて世界1位になった |

（）のようだ。中国の半導体産業は、設計フアブレス、ファンドメモリ、OSA、T、すべてにおいて、世界的な競争力をつけてある。中国が半導体大国になるのは、近いようを感じる。

くりたいのである。
最後に、パッケージングとテストを専門で行うOSAT (Out sourced Semiconductor Assembly and Test) では、世界トップ10に中国企業が3社ランクインし、3社とも前年度比で売上高が二桁成長している。それを反映して、後工程用装置の導入規模で、中国が台湾を抜いて1位になつた。